

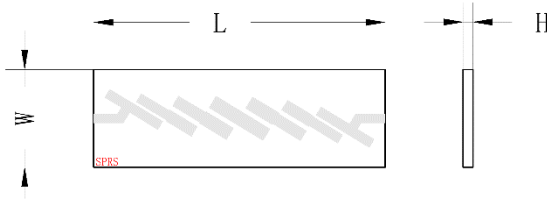
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

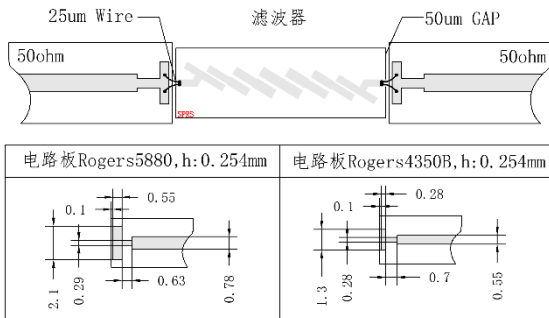
技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		48.5		GHz
工作频率	45.0		52.0	GHz
中心损耗			2.5	dB
带内波动			1.5	dB
VSWR			1.7	
带外抑制@DC-39.0GHz	40			dBc
带外抑制@56.25-60.0GHz	40			dBc
备注	大于50GHz设计保证			
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^{\circ}\text{C}$

外形图: L: 6.0, W: 1.8, H: 0.254, 端口居中



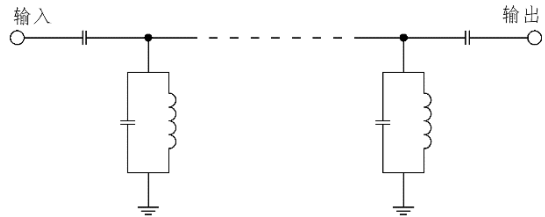
推荐装配图:



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖1.75mm，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^{\circ}\text{C}$)载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

